

# ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$

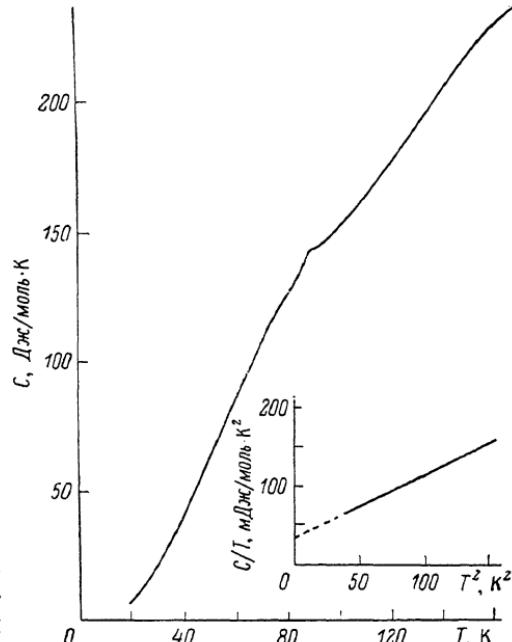
*B. Г. Веселаго, А. И. Головашкин, О. В. Ериков,  
О. М. Иваненко, А. А. Минаков, К. В. Мицен*

Исследование недавно открытых новых классов высокотемпературных сверхпроводников посвящено в последнее время значительное число работ. Однако механизм сверхпроводимости для иттриевого класса керамик пока не ясен. Имеется целый спектр теоретических предложений, начиная от фононного механизма [1] и кончая необычным механизмом резонансных валентных связей [2]. В этой связи представляют интерес эксперименты, дающие информацию об основных характеристиках, определяющих в соответствии с различными моделями параметры сверхпроводящего состояния.

Изучение температурной зависимости теплоемкости  $C$  позволяет в рамках обычной фононной сверхпроводимости оценить плотность электронных состояний на уровне Ферми  $N(E_F)$  и тем самым сделать определенные выводы о справедливости этого механизма. В настоящей работе исследована температурная зависимость теплоемкости сверхпроводящей керамики  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  в диапазоне 5—160 К. Измерения проводились на образцах, приготовленных по стандартной технологии спекания окислов соответствующих материалов. Рентгеноструктурный анализ показал однофазность полученных образцов с точностью 1—2 %. Ниже 89 К образцы имеют 100 % дипольный отклик, ширина дипольного перехода  $\leq 4$  К. Измерение теплоемкости производилось на низкотемпературном модуляционном калориметре [3].

Метод модуляционной калориметрии основан на измерении амплитуды  $T_\omega$  осцилляций температуры образца, вырезанного в виде тонкой пластины, к одной стороне которой подводится тепловой поток, промодулированный с частотой  $\omega$ . При выполнении определенных условий [3]  $T_\omega$  обратно пропорциональна теплоемкости  $C$  образца. Данный метод измерения теплоемкости имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным методом адиабатической калориметрии. Он позволяет производить измерение теплоемкости микрообразцов объемом (0.1—10)  $\text{мм}^3$  при непрерывном изменении температуры и внешних полей. Возможность непрерывной записи существенно сокращает время измерений и делает метод особенно удобным при исследовании критических зависимостей теплоемкости в окрестности точки фазового перехода. Относительная погрешность измерений 0.5 %. Минимальная регистрируемая амплитуда  $T_\omega \sim 10^{-4}$  К.

Образец для измерений имел форму диска диаметром 3 мм и толщиной 0.4 мм, масса образца  $\sim 16$  мг. На рисунке приведена зависимость  $C(T)$



Температурная зависимость теплоемкости  $C$  для образца  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ .

На вставке приведена зависимость  $C/T$  от  $T$  в низкотемпературной области.

для данного образца. При  $T \approx 91$  К наблюдается скачок теплоемкости  $\Delta C$ , размытый в диапазоне  $\sim 2$  К. Определенная экстраполяцией со стороны высоких и низких температур величина скачка  $\Delta C = 2.5$  Дж/моль·К. Наличие скачка и его величина свидетельствуют о том, что переход в сверхпроводящее состояние носит объемный характер. Из полученной экспериментально величины  $\Delta C$  можно оценить верхний предел коэффициента электронной теплоемкости  $\gamma$ . Используя простое соотношение  $\Delta C = 1.43 \eta_c \gamma^* T_c$ , получим

$$\gamma = \gamma^*/(1 + \lambda) = \Delta C / 1.43 \eta_c (1 + \lambda) T_c \lesssim 19 \text{ мДж/моль} \cdot \text{К}^2.$$

Здесь  $\gamma$  — зонное значение коэффициента электронной части теплоемкости,  $\gamma^*$  — перенормированное значение  $\gamma$ ,  $\lambda$  — константа электрон-фононного взаимодействия,  $\eta_c$  — поправка на сильную связь. При оценке верхнего предела  $\gamma$  сделано предположение, что  $\eta_c = 1$ ,  $\lambda = 0$ . Плотность электронных состояний на один спин  $N(E_F) = 3\gamma/2\pi^2k^2 \leq 1.3$  сост/эВ·ат—Си (здесь  $k$  — постоянная Больцмана). Полученная величина  $N(E_F)$  для  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  довольно мала. Она порядка или даже меньше соответствующей величины для керамики лантанового класса  $(\text{La}, \text{Sr})_2\text{CuO}_4$  и  $(\text{La}, \text{Ca}_2)\text{CuO}_4$  [4] и почти на порядок ниже, чем в сверхпроводниках с решеткой А-15. Таким образом, чтобы объяснить сверхпроводимость в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ , в рамках фононного механизма требуется предположить чрезвычайно сильное электрон-фононное взаимодействие в этом соединении. (Заметим, что в случае больших  $\lambda$  расчетная плотность состояний окажется еще меньше).

На вставке к рисунку приведена зависимость  $C/T$  от  $T^2$  в низкотемпературной области. В области 5–15 К экспериментальная кривая хорошо аппроксимируется прямолинейной зависимостью  $C/T = \gamma' + \alpha T$  с  $\gamma' \approx 30$  мДж/моль К<sup>2</sup>. Отличие  $\gamma'$  от нуля может быть вызвано либо примесью нормальной фазы (однако однофазность образца и большое значение  $\gamma' > \gamma$  делают это предположение маловероятным), либо наличием каких-то возбуждений с бесщелевым (или с очень малой щелью) спектром [2].

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Mattheiss L. F. Phys. Rev. Lett., 1987, vol. 58, N 10, p. 1028–1030.
- [2] Anderson P. W., Baskaran G., Zou Z., Hus T. Phys. Rev. Lett., 1987, vol. 58, N 26, p. 2790–2793.
- [3] Ершов О. В., Минаков А. А., Веселаго В. Г. Препринт 233, М., ФИАН, 1983.
- [4] Kitazawa K., Atake T., Sakai M., Uchida S., Takagi H., Kishio K., Hasegawa T., Fueki K., Saito Y., Tanaka S. Jap. J. Appl. Phys., 1987, vol. 26, N 2, p. L751–L752.

Физический институт им. П. Н. Лебедева  
АН СССР  
Москва

Поступило в Редакцию  
9 октября 1987 г.

УДК 539.2; 539.26; 539.27

*Физика твердого тела, том 30, № 6, 1988*  
*Solid State Physics, vol. 30, № 6, 1988*

## ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЩЕЛЕЙ В СПЕКТРАХ СПИНОВЫХ ВОЛН РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ОРТОФЕРРИТОВ

*H. K. Даньшин*

Во многих экспериментах, посвященных изучению мягких мод магнитного резонанса в редкоземельных (РЗ) ортоферритах, обнаруживаются значительные щели в спектрах спиновых волн [1–3]. Так, в точках спон-